

(11) Publication number: 2000049558 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 10210018

(51) Intl. Cl.: H03H 9/145 H03H 9/25 H03H 9/64

(22) Application date: 24.07.98

(30) Priority:

(43) Date of application

18.02.00

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: SEIKO EPSON CORP

(72) Inventor: YAMAZAKI TAKASHI

(74) Representative:

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER

(57) Abstract:

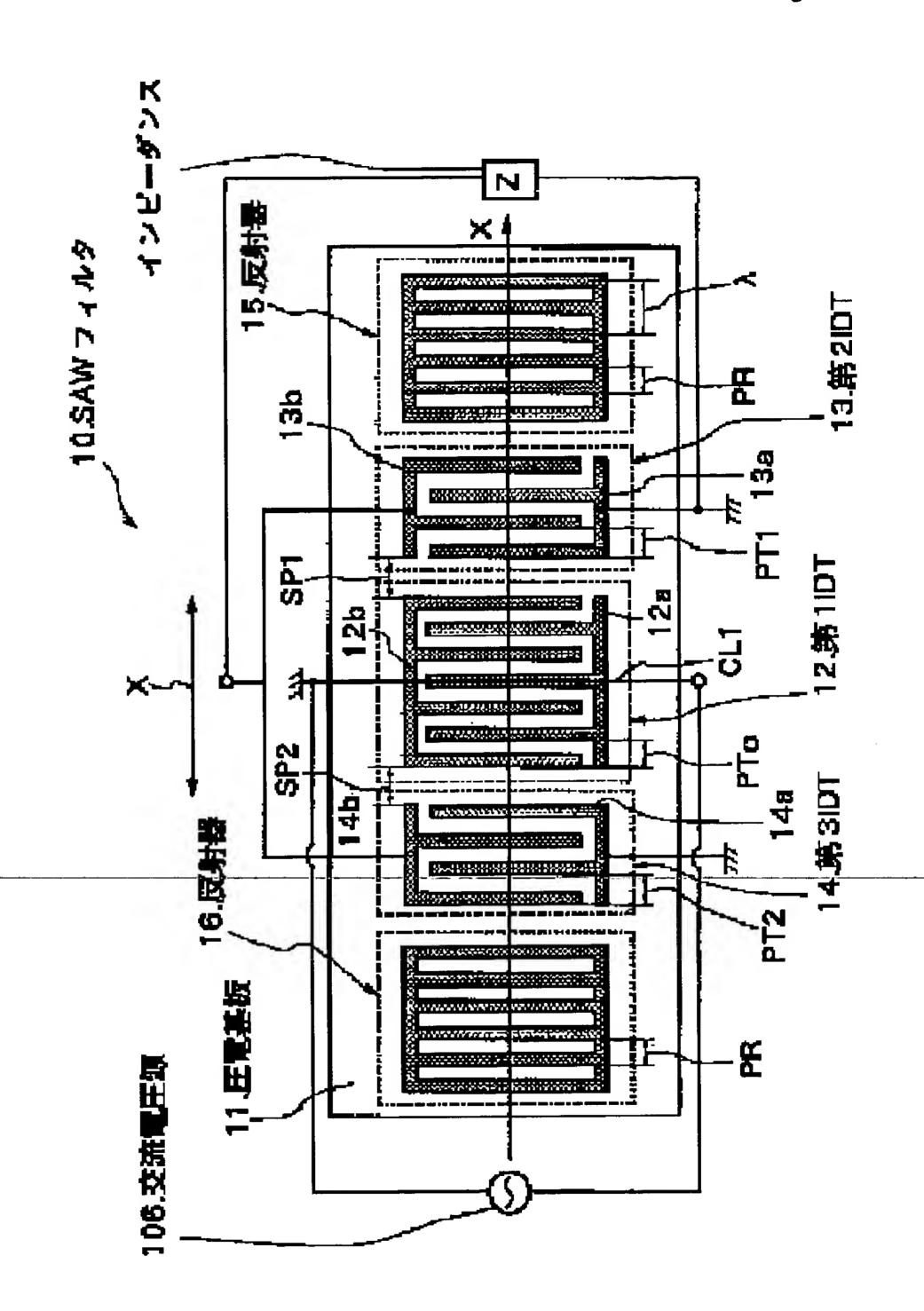
PROBLEM TO BE SOLVED: To

provide a surface acoustic wave filter which sufficiently insures the low loss of an intra-passband frequency and the attenuation outside the passband.

SOLUTION: This surface acoustic wave filter 10 has a 1st interdigital electrode 12 formed on a piezoelectric substrate 11, 2nd and 3rd interdigital electrodes 13 and 14 which are in the transmitting direction of a surface acoustic wave and are provided on both sides of the electrode 12 and 1st and 2nd reflectors 15 and 16 which are provided on both sides of the transmitting direction of the surface acoustic wave with the electrodes 12 to 14 between themselves and the interval SP1 between the electrodes 12 and 13 and the interval SP2 between the electrodes 12 and 14 are formed in such a manner that SP

1=SP2= $n\lambda$ (n=natural number) or SP1=SP2= $n\lambda+1/2\lambda$ (n=integer).

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-49558A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号		F I			テーマコード(参考)	
H03H	9/145		H03H	9/145	Α	5 J O 9 7	
					D		
	9/25			9/25	Z		
	9/64			9/64	. Z		

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21) 出願番号 特顯平10-210018

(22)出願日 平成10年7月24日(1998.7.24)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 山崎 隆

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

(74)代理人 100093388

弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

Fターム(参考) 5J097 AA01 AA14 AA16 AA18 AA33

CCO8 DD13 DD17 DD20 DD22

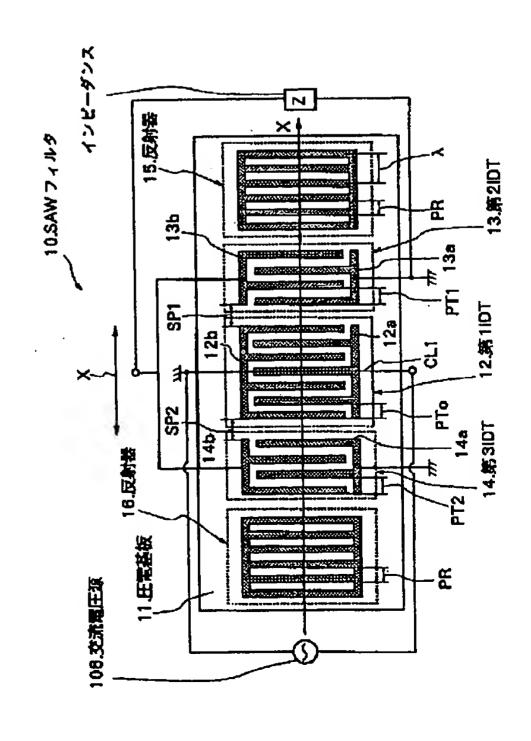
KK01 KK04

(54) 【発明の名称】 弾性表面波フィルタ

(57)【要約】

【課題】 通過帯域内周波数の低損失化と通過帯域外の 減衰量を十分に確保する弾性表面波フィルタを提供す る。

【解決手段】 圧電基板 11 上に形成されている第 1 のすだれ状電極 12 と、弾性表面波の伝搬方向であって前記第 1 のすだれ状電極 12 の両側に設けられている第 2 のすだれ状電極 13 及び第 3 のすだれ状電極 14 と、弾性表面波の伝搬方向両側にそれぞれ前記第 1 のすだれ状電極 12 乃至第 3 のすだれ状電極 14 を挟むように設けられている第 1 反射器 15 及び第 2 反射器 16 と、を有する弾性表面波フィルタ 10 であって、前記第 1 すだれ状電極 12 と前記第 2 すだれ状電極 13 の間隔 1 下れ 大電極 12 と前記第 1 すだれ状電極 13 の間隔 1 下れ 大電極 14 との間隔 14 と の間隔 14 との間隔 14 とが、 14 と前記第 14 と前記第 14 との間隔 14 とが、 14 と前記第 14 と前記第 14 とがに表すたれ 14 との間隔 14 とがに表すたれ 14 との間隔 14 との間隔 14 とがに表すたれ 14 との間隔 14 とがに表すたれ 14 との間隔 14 とがに表すたれ 14 とがに表すたれ 14 との間隔 14 とがに表すたれ 14 との間隔 14 との間の 14 に対象 14 に



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板上に複数の電極指が所定のピッチで形成されている、電気信号を弾性表面波に変換する第1のすだれ状電極と、

弾性表面波の伝搬方向であって前記第1のすだれ状電極の両側にそれぞれ所定の間隔だけ離れて設けられていて、前記第1のすだれ状電極の電極指のピッチと異なるピッチで形成されている、前記第1のすだれ状電極から伝搬する弾性表面波を電気的信号に変換する第2のすだれ状電極及び第3のすだれ状電極と、

弾性表面波の伝搬方向両側にそれぞれ前記第1のすだれ 状電極乃至第3のすだれ状電極を挟むように設けられて いて、前記第1のすだれ状電極、前記第2のすだれ状電 極及び前記第3のすだれ状電極の電極指のピッチと異な るピッチで形成されている、弾性表面波のエネルギーを 閉じ込めるための第1反射器及び第2反射器と、を有す る弾性表面波フィルタであって、

弾性表面波の波長を λ としたときに、前記第1のすだれ 状電極と前記第2のすだれ状電極の間隔SP1及び前記 第1のすだれ状電極と前記第3のすだれ状電極との間隔 SP2が、SP1=SP2=n λ (n=自然数)、ある いはSP1=SP2=n λ +1/2 λ (n=整数) にな るように形成されていることを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項2】 前記第1のすだれ状電極のピッチPT o、前記第2のすだれ状電極のピッチPT1、前記第3のすだれ状電極のピッチPT2及び第1反射器と第2反射器のピッチPRが、PTo<PT1=PT2<PR、もしくはPR<PT1=PT2<PToの関係になるように形成されている請求項1に記載の弾性表面波フィルタ。

【請求項3】 前記第2のすだれ状電極の対数と前記第 3のすだれ状電極の対数とが等しくなるように形成され ている請求項1乃至請求項2のいずれかに記載の弾性表 面波フィルタ。

【請求項4】 前記第2のすだれ状電極の対数M2と前記第1のすだれ状電極、前記第2のすだれ状電極及び前記第3のすだれ状電極の対数の総和Mの関係は、M/M2がほぼ3~4の範囲にある請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の弾性表面波フィルタ。

【請求項5】 前記対数の総和Mが150対≦M≦30 0対の範囲内にある請求項1乃至請求項4のいずれかに 記載の弾性表面波フィルタ。

【請求項6】 前記第1のすだれ状電極と前記第2のすだれ状電極間及び前記第1のすだれ状電極と前記第3のすだれ状電極間にそれぞれ第1クロスバスバー導体及び第2クロスバスバー導体が設けられている請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の弾性表面波フィルタ。

【請求項7】 圧電基板は、STカットあるいはKカットで形成された水晶板ある請求項1乃至請求項6のいず 50

れかに記載の弾性表面波フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は弾性表面波(Surface Acoustic wave)(以下、「SAW」と略す)フィルタの改良、特に、すだれ状電極(Interdigital Transducer)(以下、「IDT」と略す)のピッチを改良した縦結合型SAWフィルタに関する。

10 [0002]

【従来の技術】近年、移動体通信の分野で帯域通過型フィルタとしてSAWフィルタが多く用いられている。帯域通過型フィルタには急唆でかつ十分な遮断特性が求められるため、一般的にはSAW共振子を用いたフィルタが多く用いられている。ここで、図8には従来の弾性表面波の一例の構成図を示しており、図8を参照して弾性表面波フィルタ1について説明する。

【0003】SAWフィルタ1は圧電基板2、第1IDT3、第2IDT4、第3IDT5、第1反射器6、第2反射器7等からなっていて、圧電基板2は例えば水晶板により形成されている。第1IDT3は圧電基板2のほぼ中央部に形成されており、入力端子に接続されている。入力端子から電圧が供給されると第1IDT3は矢印X方向に向かって弾性表面波を発生する。第2IDT4及び第3IDT5は、圧電基板2上であって弾性表面波の伝搬方向側に形成されている。第2IDT4及び第3IDT5は出力端子と接続されており、弾性表面波を電気信号に変換して外部に出力する。なお各IDT3、

4、5及び各反射器6、7はそれぞれ所定のピッチでかつ所定の数の電極指が形成されている。この3個のID Tを有するいわゆる3IDT型SAWフィルタ1は、出力側負荷回路の負荷変動に対して周波数が安定であるという特性を有している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述したように移動体 通信機器やテレビ受像器等の通信システムに使用されて いるSAWフィルタは挿入損失が小さいこと、帯域外減 衰量が大きいこと及び適当な帯域幅を有していることが 条件となっている。

【0005】まず、通過帯域を広げるためには、第1反射器6と第2反射器7の間隔を広げて、各IDT3、4、5の対数を増やすことが考えられる。しかし、各IDT3、4、5の対数を増やしてしまうと、スプリアスが発生していわゆる周波数ジャンプによる通信不良を引き起こしてしまう。よって、SAWフィルタ1の広帯域化を図ることができないと同時にSAWフィルタ1の小型化を図ることができないという問題がある。

【0006】また、SAWフィルタ1には挿入損失が小さいことが要求されている。各IDT3、4、5の面積が大きくなると挿入損失が小さくなることは一般的に知

-2-

られており、電極指の交差幅をおおきくするか、もしく は対数を増やすことでIDTの面積を大きくすることが できる。しかし、各IDTの面積が大きくなると必然的 に圧電基板2の大きさも大きくなり、SAWフィルタ1 の小型化が困難となる。

【0007】さらに、移動体通信機器において、通過させる周波数帯域は高周波数域でありしかも除去する帯域の周波数は隣接しているため、SAWフィルタには急峻でかつ十分な遮断特性が要求される。しかし、SAWフィルタ1において、IDTの対数を多くすると、各IDT3、4、5内における内部反射により生じるスプリアスにより、通過周波数帯域より低い周波数での十分な減衰量が得られないため前記3個のIDTを持つSAWフィルタ1において、通過帯域より低周波数側において急峻でかつ十分な遮断特性が得られないという問題がある。

【0008】そこで本発明は低損失化と通過帯域外における減衰量を十分に確保するSAWフィルタを提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、圧電 基板上に複数の電極指が所定のピッチで形成されてい る、電気信号を弾性表面波に変換する第1のすだれ状電 極と、弾性表面波の伝搬方向であって前記第1のすだれ 状電極の両側にそれぞれ所定の間隔だけ離れて設けられ ていて、前記第1のすだれ状電極の電極指のピッチと異 なるピッチで形成されている、前記第1のすだれ状電極 -から伝搬する弾性表面波を電気的信号に変換する第2の すだれ状電極及び第3のすだれ状電極と、弾性表面波の 伝搬方向両側にそれぞれ前記第1のすだれ状電極乃至第 3のすだれ状電極を挟むように設けられていて、前記第 1のすだれ状電極、前記第2のすだれ状電極及び前記第 3のすだれ状電極の電極指のピッチと異なるピッチで形 成されている、弾性表面波のエネルギーを閉じ込めるた めの第1反射器及び第2反射器と、を有する弾性表面波 フィルタであって、弾性表面波の波長をえとしたとき に、前記第1のすだれ状電極と前記第2のすだれ状電極 の間隔SP1及び前記第1のすだれ状電極と前記第3の すだれ状電極との間隔SP2が、SP1=SP2=n λ (n=e) (n=e) 、あるいはSP1=SP2= $n\lambda+1$ 2λ (n=整数) になるように形成されている弾性表面 波フィルタである。

【0010】この請求項1では、通過帯域外周波数の挿入損失を大きくして、十分な減衰量を確保することができるとともに、縦インハーモニックモードを低減させて、いわゆる周波数ジャンプによるフィルタリング不良を低減することができる。

【0011】請求項2の発明は、請求項1の構成において、前記第1のすだれ状電極のピッチPTo、前記第2のすだれ状電極のピッチPT1、前記第3のすだれ状電

極のピッチPT2及び第1反射器と第2反射器のピッチPRが、PTo<PT1=PT2<PR、もしくはPR</p>
<PT1=PT2<PToの関係になるように形成されている弾性表面波フィルタである。</p>

【0012】この請求項2では、第1のすだれ状電極乃 至第3のすだれ状電極及び反射器のピッチをいわゆる周 波数上昇型、もしくは周波数下降型にする事により、縦 インハーモニックモードを低減させて、いわゆる周波数 ジャンプによるフィルタリング不良を低減することがで きる。

【0013】請求項3の発明は、請求項1乃至請求項2のいずれかの構成において、前記第2寸だれ状電極の対数と前記第3寸だれ状電極の対数とが等しくなるように形成されている弾性表面波フィルタである。

【0014】この請求項3では、第2のすだれ状電極と 第3のすだれ状電極の対数を等しくする。これにより、 第1のすだれ状電極を中心とした左右対称の形状に形成 されて入力インピーダンスと出力インピーダンスの終端 条件が同じになり、急峻なフィルタ特性を得ることがで 20 きる。

【0015】請求項4の発明は、請求項1乃至請求項2の構成において、前記第2のすだれ状電極の対数M2と前記第1のすだれ状電極、前記第2のすだれ状電極及び前記第3のすだれ状電極の対数の総和Mの関係は、M/M2がほぼ3~4の範囲にある請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の弾性表面波フィルタである。

【0016】この請求項4では、対数の総和Mとの関係は、M/M2がほぼ3~4の範囲に設定することで、通過帯域内周波数の挿入損失を小さくして通過帯域内の減衰量を小さくすることができる。

【0017】請求項5の発明は、請求項1乃至請求項4のいずれかの構成において、前記対数の総和Mが150対≤M≤300対の範囲内にある弾性表面波フィルタである。

【0018】この請求項5では、前記対数の総和Mが150対≤M≤300対の範囲内に設定することで、市場要求を満足する小型サイズとフィルタ性能を備えた弾性表面波フィルタを実現することができる。

【0019】請求項6の発明は、請求項1乃至請求項5のいずれかの構成において、前記第1のすだれ状電極と前記第2のすだれ状電極及び前記第1のすだれ状電極と前記第3のすだれ状電極間にそれぞれ第1クロスバスバー導体及び第2クロスバスバー導体が設けられている弾性表面波フィルタである。

【0020】この請求項6では、第1クロスパスパー導体及び第2クロスパスパー導体を設けることで、第1のすだれ状電極と第2のすだれ状電極、および第1のすだれ状電極と第3のすだれ状電極の電気的分離を強めることができ、加えて第1のすだれ状電極乃至第3のすだれ状電極を外部端子と接続する際のワイヤボンディング数

を少なくすることができる。

【0021】請求項7の発明は、請求項1乃至請求項6のいずれかの構成において、圧電基板は、STカットあるいはKカットで形成された水晶板である弾性表面波フィルタである。

【0022】この請求項7では、圧電基板にSTカット あるいはKカットの水晶板を用いて、温度変化等の外界 の影響を受けにくい弾性表面波フィルタを作製する事が できる。

[0023]

【発明の実施の形態】第1の実施の形態

以下、この発明の好適な実施の形態を図面に基づいて説 明する。

【0024】図1は本発明の縦結合型SAWフィルタの電極パターンの好ましい実施の形態を示す平面図であり、図1を参照してSAWフィルタ10について詳しく説明する。図1のSAWフィルタは、圧電基板11、第1IDT12、第2IDT13、第3IDT14、反射器15、16等からなっている。圧電基板11は例えば水晶板であって、水晶より切り出されたST-X伝搬カット、LST-X伝搬カット、Kカットなどの特定のウェハをダイシングして得られる素子片である。

【0025】この圧電基板11を伝搬する弾性表面波の速度Vは、圧電基板11の材料、第1IDT12乃至第3IDT14及び反射器15、16の厚さや幅等によって決定される。この圧電基板11の表面上をレーリー波、リーキー波、STW (Surface Transversal-Wa-ve)-波等の弾性表面波が矢印X方向に向かって伝搬する。

【0026】第1IDT12は圧電基板11のほぼ中央部に形成されており、複数の電極指からなるくし型電極12a、12bからなっている。くし型電極12a、12bは後述する所定のピッチPTo及び所定の対数M1で形成される。第1IDT12には入力端子が接続されていて、入力端子は交流電圧源106に接続されている。入力端子から交流電圧が供給されると、第1IDT12から弾性表面波が励振する。

【0027】第1IDT12の弾性表面波伝搬方向である矢印X方向には、励振された弾性表面波を電気信号に変換して出力する第2IDT13と第3IDT14が形 40成されている。第2IDT13はくし型電極13a、13bからなっており、第3IDT14はくし型電極14a、14bからなっている。くし型電極13aとくし型電極14a及びくし型電極13bとくし型電極14bはそれぞれ電気的に接続されて、第2IDT13と第3IDT14とは並列に接続されている。第2IDT13と第3IDT14はそれぞれ後述する所定のピッチPT1、PT2及び所定の対数M2、M3で形成されている。第2IDT13と第3IDT14には電気的負荷インピーダンスZに接続されていて、第2IDT13及び 50

第3IDT14が出力する電気信号を検出する。第2IDT13と第3IDT14は第1IDT12からそれぞれ間隔SP1、SP2だけ離れて形成されている。

【0028】第2IDT13と第3IDT14の各電極指はこのましくは互いに同一のピッチ (PT1=PT2)で同一の対数 (M2=M3)及び同一の間隔 (SP1=SP2)で形成されている。これにより、SAWフィルタ10は中心線CL1に対して対称になるように設けられるため、入力インピーダンスと出力インピーダンスの終端条件が同一になり、良好なフィルタ特性を得る

10 スの終端条件が同一になり、良好なフィルタ特性を得ることができる。

【0029】第2IDT13及び第3IDT14の弾性表面波伝搬方向には反射器15、16が設けられている。第1反射器15及び第2反射器16は後述する所定のピッチPRであって所定の本数M4で形成されている。反射器15、16は第1IDT12から出力された弾性表面波を反射して第1反射器15及び第2反射器16内に閉じ込め、多段反射することで定在波を形成する。上述した第1IDT12、第2IDT13、第3IDT14、第1反射器15及び第2反射器16は圧電基板11上に、A1、Au、Cu等の導体金属膜を蒸着あるいはスパッタリング等の成膜形成手段により形成した上で、フォトリソグラフィ技術によりパターン形成される。

【0030】ここで、図1のSAWフィルタが挿入損失 が小さく通過周波数帯域外での減衰量が大きい急峻で十 分なフィルタ特性を持つためのパラメータ設定について 考察する。一般的にSAWフィルタの特性は、各IDT 12、13、14及び反射器15、16の各電極指のピ ッチ、間隔SP1、SP2及び対数、電極指の膜厚と幅 等によって決定されるが、この中でも各IDT12、1 3、14及び反射器15、16の各電極指のピッチ、間 隔SP1、SP2及び対数のパラメータについて考察す る。なお、図2乃至図9に示されるグラフ図はスミスの 等価回路を用いたシミュレーションにおける結果を示し ているが、実際のSAWフィルタ10における実測値と シミュレーション値には食い違いが生じる場合がある。 しかしSAWフィルタ10の特性は一致するものである から、シミュレーション結果に基づいて考察するものと *40* する。

【0031】まず、第1IDT12乃至第3IDT14 と反射器15、16のピッチについて詳しく説明する。 一般的に角周波数ωは以下の式で与えられる。

【0032】 $\omega=2\pi f=2\pi V/\lambda \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ ここで、f は弾性表面波の周波数、V は弾性表面波の速度、 λ は弾性表面波の波長を示している。波長 λ は各 I D T 及び反射器のピッチの 2 倍($\lambda=2$ P; P= ピッチ)となるため、式(1)は以下の式に変形することができる。

[0033] $\omega = 2 \pi f = 2 \pi V / 2 P \cdot \cdot \cdot (2)$

このとき、図1の各IDT及び反射器のピッチが以下の 式になるように形成すると、通過帯域外の周波数におけ る挿入損失を大きくすることができ、通過帯域外におけ る減衰量を大きく確保することができる。

[0034]

PToPT1=PT2PR・・・(3)なお、上述したように、PToは第1IDT12の電極指のピッチ、PT1は第2IDT13の電極指のピッチチ、PT2は第3IDT14の電極指のピッチ、PRは各反射器15、16の電極指のピッチである。

【0035】ここで、図2を参照して上述の事項を詳しく説明する。図2は図1における各IDTおよび反射器の角周波数に関する概念図を示しており、横軸は前述図1における弾性表面波の位相伝搬方向の距離であり、縦軸は各IDTおよび各反射器における角周波数 ω である。また、第1IDTの対数M1=105対、第2IDT13および第3IDT14の対数M2=M3=60対、各反射器15、16の電極指の本数MR=109本とし、第1IDT12と第2IDT13間及び第1IDT12と第3IDT14間の距離SP1、SP2はSP1=SP2=n λ +1/2 λ (n=整数)に設定されている。

【0036】式 (2) を見ると、角周波数 ω は電極指のピッチに反比例していることがわかる。よって、各 I D T 12、13、14及び各反射器 15、16の各電極指のピッチを式 (3) のように設定すると、式 (2) により以下の式が導き出され、図 2 のようなグラフになる。 (2) の (2) の (3) の (3) の (4) の (

なお、第1 I D T 1 2 の角周波数を ω 1、第2 I D T 1 3 の角周波数を ω 2、第3 I D T 1 4 の角周波数を ω 30 3、反射器 1 5、16 の角周波数を ω R とする。図3には、式(4)のように設定したときの周波数一挿入損失特性を示しており、図3のグラフ301は ω 1 = ω 2 = ω 3 = 2762 (rad/s)に設定した場合の周波数一挿入損失特性を示し、グラフ302は ω 1 = 2762 (rad/s)、 ω 2 = ω 3 = 2754 (rad/s)、 ω R = 2750 (rad/s)に設定した場合の周波数一挿入損失特性を示している。図3においてグラフ301では通過周波数帯域より下側の周波数領域で外部回路を用いて整合を図っても縦インハーモニックモー 40

ド303が発生しているのに対し、式(4)のように設定し外部回路を用いて整合を図ることにより線302には発生していない。これは、式(4)のように設定することにより、弾性表面波のエネルギーが第1IDT12により強く閉じ込められ、第2IDT13と反射器15及び第3IDT14と反射器16の端部を節とする内部反射が減少するからであり、これにより縦インハーモニ

ックモード303が発生しなくなる。 【0038】以上のことから、各IDT12、13、1 4及び反射器15、16の電極指のピッチを式(3)の 50

ように設定し、かつ第1 I D T 1 2 と第2 I D T 1 3 の間隔 S P 1 及び第1 I D T 1 2 と第3 I D T 1 4 の間隔 S P 2 とを S P 1 = S P 2 = $n\lambda$ (n= 自然数) もしくは S P 1 = S P 2 = $n\lambda$ + $1/2\lambda$ (n= 整数) に設定することで、SAWフィルタ10は、縦インハーモニックモード303による周波数ジャンプを起こすことなく、通過帯域外の周波数を確実に遮断することができる。

【0039】尚、参照文献として鈴木、滝水、山内等の文献「エネルギー閉じ込め弾性表面波共振子」、信学技報、US87-36、pp.9-16 (1980)が挙げられる。さらにこの角周波数の構成が妥当であるのは、水晶ST-Xカット、Kカット等の圧電基板にアルミニウムで電極構成した、いわゆるエネルギー下降型の波数分散特性をもつ場合である。もし前記カット圧電基板に金電極を形成した場合のような、周波数降下型の波数分散特性をもつ場合においては、図2の角周波数ωの大小関係を全部逆に設定する必要がある。

【0040】次に、図4を参照して各 I D T 12、 1 3、 14の対数について考察する。なお、図4はM=150対、M=225対、M=300対に設定した際、各対数の総和と通過帯域の周波数における挿入損失とのグラフ図を示している。なお、M=M1+M2+M3、D I V=M/M2=M/M3とする。図4で示されるように、挿入損失が最小となるD I Vの範囲はほぼ $3 \le D$ I $V \le 4$ の範囲にあることがわかり、対数の総和Mが大きくなると挿入損失が小さくなることも示されている。

【0041】これは、弾性表面波を発生する第1IDT 12の面積と弾性表面波を検出する第2IDT13と第3IDT14の合計面積とがほぼ等しくなること(DIV=4.0)が望ましいが、弾性表面波のエネルギーが第1IDT12により強く閉じ込められている分、第2IDT13と第3IDT14の合計面積を第1IDT12の面積より多少大きく設定した範囲においても挿入損失が最小となることを示している。また、対数の総和Mが大きくなると挿入損失が小さくなるのは、反射器15、16に挟まれている各IDT12、13、14の面積が大きくなったからであり、各IDT12、13、14の面積が大きくなったからであり、各IDT12、13、14の面積が大きくなると挿入損失が小さくなることは一般的に知られている。

【0042】以上のことから $3 \le DIV \le 4$ に設定することで、通過周波数帯域内における挿入損失を小さく設定することが可能となる。ここで、SAW74V910の小型化、実用化の観点からM=150対〜300対が妥当であるため、図4にはM=150対、M=225対、M=300対に設定した場合のみ言及している。しかし、150対 $\le M \le 300$ 対の範囲はもちろんのこと、M < 150対もしくはM > 300対の範囲においても、ほぼ $3 \le DIV \le 4$ の範囲で挿入損失が最小になる。ただし、M < 150対の範囲では挿入損失が大きく

-5-

なり実用的ではなく、またM>300対の範囲では挿入 損失は十分小さいが、小型化に逆行し実用的ではない。

損失は十分小さいが、小型化に逆行し実用的ではない。 【0043】つぎに図5における、第11DT12と第 2 IDT13間の距離SP1および第1IDT12と第 3 I D T 1 4 間の距離 S P 2 の変化に対する縦結合型 S AWフィルタの伝送特性の変化を示している。図5にお いて、グラフ501はSP1=SP2=nλ (n=自然 数) あるいはSP1=SP2= $n\lambda+1/2\lambda$ (n=整数) と設定した際の伝送特性を示し、グラフ502はS $P1=SP2=n\lambda+1/4\lambda$ (n=整数) あるいはS $P1=SP2=n\lambda+3/4\lambda$ (n=整数) と設定した 際の伝送特性を示す。グラフ502は1つの共振モード のみをもつ共振子特性であり、広帯域なフィルタとして は機能しない。一方グラフ501は後述する図6 (B) の二つのほぼ同等振幅のピークP2、P3が励振されて おり通過周波数帯域を有するSAWフィルタ10が実現 できる。これは、第1IDT12の中心線CL1におい て振動強度が最も強いピークを持つモードと、第1 I D T12と第2IDT13の境界と第1IDT12と第3 IDT14の境界において振動強度が最も強いピークを 持つモードの2つのモードが励振されて、2つの共振ピ 一クが現れるためである。

【0044】図6には、上述した各IDT12、13、14及び反射器15、16の各電極指のピッチの最適化、スペースSP1、SP2の最適化及び第2IDT13と第3IDT14の対数M2、M3の最適化を図った際の周波数一挿入損失のグラフ図を示している。

【0.0.4.5】まず図6_(A)」は、第1.IDT12、第2IDT13、第3IDT14の対数M1、M2、M3が等しく(M1=M2=M3)、間隔SP1=SP2=n $\lambda+1/4$ λ (n=自然数) あるいはSP1=SP2=n $\lambda+3/4$ λ (n=整数) に形成されている場合の周波数一挿入損失のグラフを示している。図6 (A) において、周波数一挿入損失には1つのピークP1が現れているのみで、周波数帯域フィルタとしての機能を果たすことはできない。

【0046】次に、 $SP1=SP2=n\lambda$ ($n=ext{log}$ 数)もしくは $SP1=SP2=n\lambda+1/2\lambda$ ($n=ext{log}$ 数)になるように第2IDT13と第3IDT14を形成し、第2IDT13及び第3IDT14の対数の数を $3 \le M/M2 \le 4$ 内に設定し、さらにPTo < PT1=PT2 < PRになるように形成すると、図6(B)において2つのピークP2、P3が現れる。そして外部の整合回路により適切な整合を行うことにより、図 $ext{log}$ 6(C)に示すように縦ハーモニックモードの出現を防止して通過帯域内において低損失化を実現した、良好なフィルタ特性を示すことができる。尚、 $ext{log}$ 6(C)の部位 $ext{log}$ 7)ないた。入力インピーダンスと出力インピーダンスの終端条件を同じにすることができ、図 $ext{log}$ 6(C)の部位 $ext{log}$ 7)の

10

1、702の勾配を急峻にする事ができる。

【0047】第2の実施の形態

図7には第2の実施の形態を示す平面図を示しており、 図7を参照してSAWフィルタについて詳しく説明す る。尚、第2の実施形態では第1の実施形態と同様な部 分に付いては同一の符号を付してその説明を省略し、異 なる部分を中心に説明する。

【0048】図7のSAWフィルタ600Aが図1のSAWフィルタ10と異なる点は、クロスバスバー導体が形成されていることである。第1クロスバスバー導体610、第2クロスバスバー導体611は第1IDT12と第2IDT13の間及び第1IDT12と第3IDT14の間にそれぞれ形成されている。第1クロスバスバー導体610と第2クロスバスバー導体611は弾性表面波の伝搬方向に対して垂直に幅Bで形成されており、電気的に接地されている。これにより、SAWフィルタ600Aは図1のSAWフィルタ10と同様の作用効果を発揮するとともに、第1IDT12と第2IDT13、および第1IDT12と第3IDT14の電気的分離を強めることができる。

【0049】さらに第1IDT12、第2IDT13、第3IDT14の同電位電極を平面的に導通させることにより、パッケージグラントとの間のワイヤボンディング数を少なくすることができる。なおクロスバスバー610、611の導体幅Bと第1のIDT12の端部12 bの両側における間隔すだれ状電極間の長さの合計長B+SPi+SPoであり、 $B+SPi+SPo=n\lambda$ (n=整数)あるいは $B+SPi+SPo=n\lambda+1/2\lambda$ (n=整数)に設定すれば、図5とほぼ同じような伝送特性が得られる。よって、二つのほぼ同等振幅のモードが励振されておりSAWフィルタが実現できる。

【0050】本発明は上記実施の形態には限定されない。図1において、第1IDT12の本数は例えば105対に形成されているが、電極指を1本減らした場合であっても得られるフィルタ特性は同じものとなる。その理由は以下の通りである。第1IDT12の対数を変更することは、中心間距離SP1もしくはSP2が変わってしまい、フィルタの位相が変わってしまうように思われる。しかし、第1IDT12の電極指は1/21ビッチで形成されているため、見かけ上中心距離が変わっても、得られるフィルタ特性は変わらない。

[0051]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1と請求項2の発明によれば、十分な周波数通過帯域を形成して、かつ通過帯域内での挿入損失を小さくして減衰量を小さくすることができるとともに、縦インハーモニックモードを低減させて周波数ジャンプによるフィルタリング不良を低減することができる。

【0052】請求項3の発明によれば、通過帯域と通過 帯域外との境において急峻なフィルタ特性を得ることが

できる。

【0053】請求項4と請求項5の発明によれば、第2 IDTと第3IDTの対数を調整して、周波数通過帯域 内において低損失化を実現することができる。

11

【0054】請求項6の発明によれば、各IDTを電気的に接続するためのワイヤボンディングの数を減らすことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の弾性表面波フィルタの好ましい実施 の形態を示す平面図。

【図2】 本発明の弾性表面波フィルタにおける各 I D T及び反射器の角振動数特性を示すグラフ図。

【図3】 弾性表面波フィルタにおける周波数-挿入損 失特性を示すグラフ図であって、本発明の特性と従来技 術の特性とを比較したグラフ図。

【図4】 弾性表面波フィルタにおけるIDT分割数DIV-挿入損失特性を示すグラフ図であって、本発明の

特性と従来技術の特性とを比較したグラフ図。

【図5】 本発明の弾性表面波フィルタにおける各 I D T及び反射器の角振動数特性を示すグラフ図。

【図6】 弾性表面波フィルタにおける周波数-挿入損 失特性を示すグラフ図であって、(A)は従来技術の特 性、(B)、(C)は本発明の特性を示すグラフ図。

【図7】 本発明の弾性表面波フィルタにおける別の実施の形態を示す平面図。

【図8】 従来の弾性表面波フィルタの一例を示す平面 10 図。

【符号の説明】

10···SAWフィルタ (弾性表面波フィルタ)

11・・・圧電基板

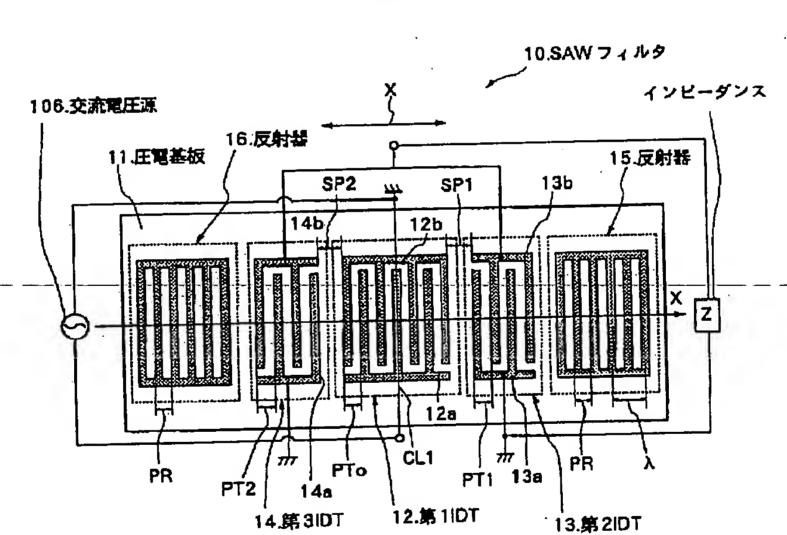
12···第1 I D T

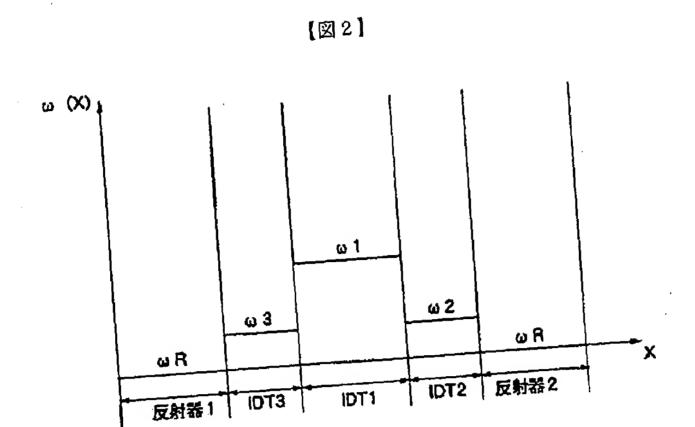
13···第2 I D T

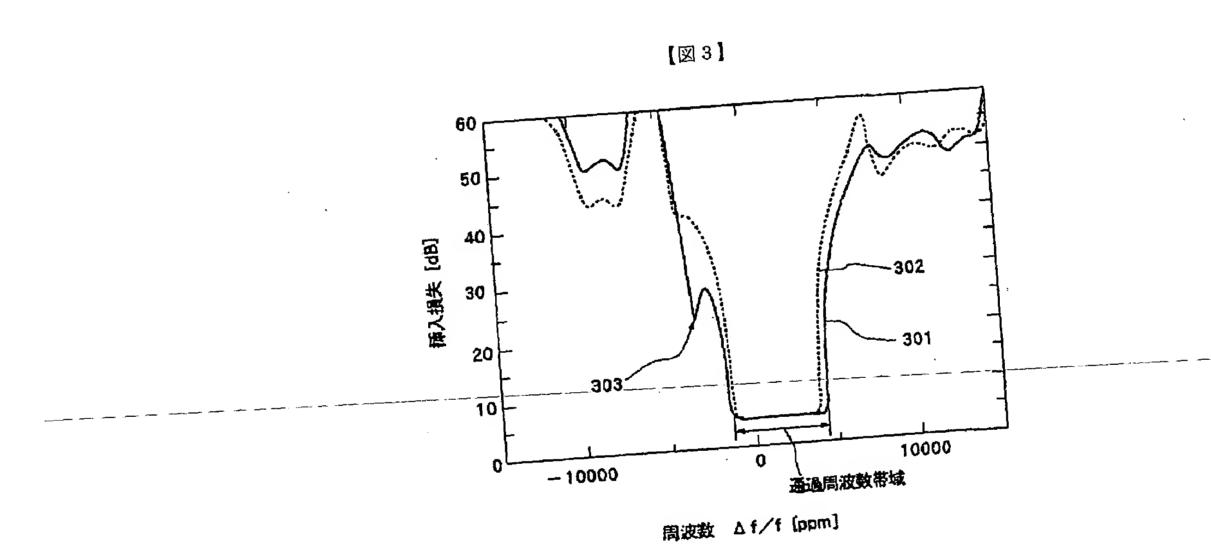
14···第3 I D T

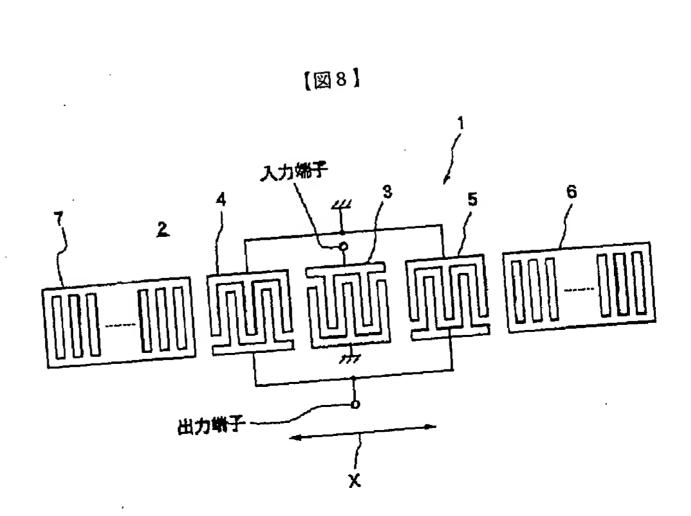
15、16・・・反射器

【図1】

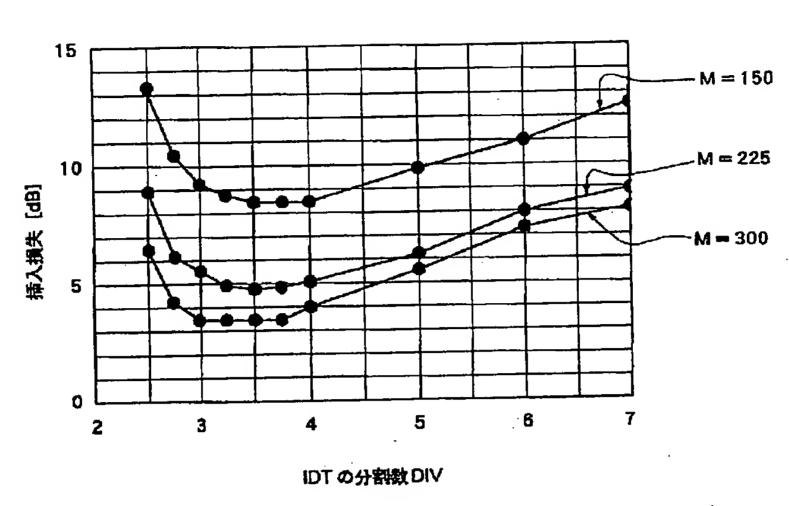












【図5】

